

集成电路学院 2026 年专业学位（工程类博士） “申请-考核”制招考说明

院系简介

一、学院基本情况

华中科技大学自 1960 年 3 月开始创办半导体相关专业,经过 60 余年的发展,学校已经拥有了雄厚的集成电路学科基础。2003 年,华中科技大学成为国家建设的首批九个国家集成电路人才培养基地之一。2007 年,“微电子学与固体电子学”被评为国家重点学科。2015 年,华中科技大学成为首批国家示范性微电子学院筹建单位。

2021 年,华中科技大学揭牌成立集成电路学院。2021 年 5 月,华中科技大学获批建设国家集成电路产教融合创新平台(全国八家)。2021 年 11 月,华中科技大学成为国家首批建设“集成电路科学与工程”一级学科的高校。2023 年 6 月获批建设国家集成电路学院。

集成电路学院负责建设集成电路科学与工程、电子科学与技术两个一级学科。学院已建立了完善的人才培养体系,建设了集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子科学与技术 3 个国家级一流本科专业;拥有集成电路科学与工程、电子科学与技术、电子信息专业硕士/博士点,以及两个一级学科博士后流动站。目前在校就读学生 2500 余人,其中研究生 1100 余人。

二、学科专业介绍

学院秉承“为党育人,为国育才”的宗旨,按照“国际视野、拔尖示范、协同育人、自主创芯、服务地方”的思路,通过人才培养、科学研究、学科建设“三位一体”,充分发挥产教融合优势,培养工程型、创新型和领军型高层次人才,凝练学科发展方向,聚力“卡脖子”问题,服务国家重大战略和区域经济发展。

学院已形成一支由院士和教育部长江学者特聘教授为学科带头人的高水平师资队伍,拥有专职教师 and 教学实验人员 100 余人,其中教授(研究员) 57 人,副教授(副研究员) 32 人,讲师及工程师 17 人,另聘有 60 余位企业专家担任兼职研究生导师。师资队伍中青年千人、青年长江学者、优青、海外优青、青年拔尖、湖北省杰青、湖北省拔尖、湖北省百人计划、湖北省楚天学者、中国科协青年托举等青年人才济济,面向卓越工程师培养的创新型实践型师资队伍进一步获得完善。

三、科研平台

集成电路学院拥有的重要科研教学平台包括:国家集成电路产教融合创新平台、国家集成电路人才培养基地、国家示范性微电子学院、电子信息功能材料教育部重点实验室、教育部敏感陶瓷工程研究中心、先进存储器湖北省重点实验室、

湖北省微电子工程技术研究中心等。

学院与武汉光电国家研究中心、湖北光谷实验室、湖北九峰山实验室、湖北江城实验室、国家先进存储产业创新中心等重要科研机构建立了紧密合作关系，还可利用华中科技大学分析测试中心、校级微纳工艺平台等资源。

学院与产业界合作密切（如中电科、中国电子信息产业集团、航天科工、长江存储、华为、新思科技、华星光电、高德红外、OPPO、深圳国微等），共建了一批校企联合实验室和联合研究中心，签订了研究生校企联合培养合作协议。

四、研究生培养

学院历年来积极服务国家战略和区域经济社会发展，培养输送了一批高水平创新人才投身集成电路行业，推动了“武汉·中国光谷”集成电路产业从无到有，参与支撑了总投资超 2000 亿元的国家存储器产业基地落户武汉，目前正源源不断为湖北省科技创新十四五规划中“光芯屏端网”万亿级支柱产业的发展提供助力。

针对集成电路“卡脖子”问题和原创性科技创新战略需求，学院结合学科基础，传承学科优势，凝练科研方向，重点建设“先进存储器”、“智能微系统”、“集成电路设计及 EDA”、“信息安全芯片”、“人工智能芯片”、“射频芯片”、“车规芯片”、“微波材料与器件”、“化合物半导体”等研究方向。

学院紧抓国家集成电路学院和产教融合创新平台建设的契机，通过需求导向，全面深化产教融合、协同育人，以国家卡脖子技术、地方集成电路产业集群特色为牵引，以龙头企业发展需求为切入点，优化人才培养方向与特色，通过精准链接学校科研团队进行联合技术攻关，充分利用集成电路企业已有技术资源、管理经验等，加强研究生实践环节培养，提升卓越工程师人才培养水平。

五、拟招生计划

工程类博士只招收全日制非定向和非全日制定向类型（全日制定向生仅限专项计划），不接收同等学力考生报考。

学院研究生工作网址：

研究生培养-华中科技大学集成电路学院

<http://ic.hust.edu.cn/rcpy1/yjspy.htm>

导师信息见：

师资队伍-华中科技大学集成电路学院

<http://ic.hust.edu.cn/szdw/xysz.htm>

专业学位招生专业目录及报考条件

一、学科（类别）及研究方向

085401 新一代信息技术（含量子技术等）

01（全日制）电子元器件与系统

01（非全日制）电子元器件与系统

085403 集成电路工程

00（全日制）不区分研究方向

00（非全日制）不区分研究方向

二、申请条件

1. 符合我校博士生招生简章规定的报考条件。

2. 外语水平满足以下条件之一：

（1）全国大学英语六级考试（CET-6）成绩达到 425 分及以上（须提供成绩证书及中国教育考试网 <http://cjcx.neea.edu.cn/> 查询成绩的截图）。涉及其他语种的，以国内相应语种六级或专业四级成绩合格为参考。

（2）全国高校英语专业八级考试（TEM-8）合格。

（3）TOEFL 成绩（iBT）达到 90 分及以上；或 IELTS 成绩达到 6 分及以上；或 GRE 成绩达到 300 分及以上；或 GMAT 成绩达到 650 分及以上。

（4）本科或硕士阶段获外语专业的学位证书或毕业证书。

（5）在国（境）外有 1 年以上（含 1 年）全日制学习或研究经历（英语为当地主要日用语言和授课语言），须提供国外学习经历的证明、学历学位证书或成绩单。

（6）以第一作者身份在中国科学院期刊分区表三区及以上国际期刊上发表英文文章。（需提供证明）

3. 具有良好的学术科研能力，取得以下学术成果之一（全日制考生需提供）：

（1）以第一作者（或导师为第一作者，考生为第二作者）公开发表（含录用待发表）的与申请专业相关的 SCI 期刊学术论文 1 篇。

（2）本学科 GF 报告 1 篇（论文有效期 3 年）。

（3）集成电路领域高水平核心学术会议论文（IEDM、ISSCC、VLSI、CICC、ESSCIRC、A-SSCC、ICCAD、DAC、DATE、ASP-DAC、IECON、FPGA、FPT、ISPSD、ISCA、MICRO 等会议发表的正式论文）。

（4）已授权发明专利。

（5）学院认可的其他成果。

4. 由本专业领域 2 名专家推荐。推荐专家信息由考生在报名系统中提供，必须

提供准确的邮箱地址和手机联系方式。

5. 单位推荐信和参与工程项目证明材料（非全日制定向考生需提供）。

提交材料清单

1. 《华中科技大学攻读博士学位期间的研究计划》，模板参见学校研究生招生信息网附件。

2. 本科、硕士阶段学业成绩单（须加盖学校教务或人事档案部门公章）。

3. 硕士学位论文（往届生提交），硕士学位论文开题报告或研究工作进展报告（应届生提交）。如涉密工作必须事先进行脱密处理。

4. 具有代表性的科学研究成果，如公开发表的学术论文、所获专利及其他原创性研究成果的陈述和证明。

5. 满足报考院系外语水平要求的各类证书或证明材料。注：大学英语六级成绩除证书外，还须提供中国教育考试网（<http://cjcx.neea.edu.cn>）查询结果截图。

6. 在职人员报考需提供相关证明。报考专业学位工程类别博士需单位推荐意见及相关经历证明等。

7. 提供 2 名推荐专家的基本信息和有效联系方式。1 名专家要求是拟报考导师，另 1 名专家为报考学科或专业类别相关的教授（或相当专业技术职称人员）或企业技术主管（或负责人），我校将通过系统向推荐专家发送邮件和短信，由推荐专家在线提交意见。请考生提前联系好推荐专家，并获取准确有效的联系方式（邮箱与联系电话）。

8. 报考非全日制定向工程类博士申请需提交的其他材料：

（1）所在单位推荐信 1 封（提供考生实际工作年限、参与科研及管理工作情况，加盖人事部门公章），报名系统中上传。

（2）参与工程项目证明材料（主持或作为骨干参与过重要工程项目，或正在承担相关工程领域的研究项目证明，需要提交项目申请书、验收报告或结题报告等材料中可证明申请者参与该项目的人员名单页，涉密项目需要由单位保密部门提供相关证明）。

材料提交方式

考生申请材料提交及缴费务必在 2026 年 1 月 19 日 17:00 前在我校博士“申请-考核”报名系统完成。

学院将对申请材料符合报考说明要求的情况进行初审并反馈意见。已在 1 月 19 日前完成材料提交及缴费的考生可根据反馈意见修改或补充材料，截止时间为 1 月 22 日 17:00 前（包括推荐人在系统提交推荐意见）。系统关闭后不再接

收补充材料。

联系人：邢老师 咨询电话：027-87542868

咨询邮箱：xingxinyu@hust.edu.cn